(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-60719 (P2002-60719A)

(43)公開日 平成14年2月26日(2002.2.26)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコート*(参考)
C O 9 J 183/07		C 0 9 J 183/07	4J035
C 0 8 G 77/50		C 0 8 G 77/50	4 J 0 4 0
C 0 9 J 183/05		C 0 9 J 183/05	5 F 0 4 7
H01L 21/52		H 0 1 L 21/52	E

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)

(21)出願番号 特願2000-249381(P2000-249381) (71)出願人 000002060

(22) 出願日 平成12年8月21日(2000, 8, 21) 東京都千代田区大手町二丁目6番1号

水水即11位位入1-11-110年15

(72)発明者 滝田 健一

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料

技術研究所内

(74)代理人 100079304

弁理士 小島 隆司 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 接着性シリコーンゴム組成物及び半導体装置

(57)【要約】

【解決手段】 (1)1分子中にケイ素原子に結合したアルケニル基を2個以上含有するオルガノポリシロキサン、(2)1分子中にケイ素原子に結合した水素原子を2個以上含有するオルガノハイドロジェンポリシロキサン、(3)接着性付与剤、(4)付加反応触媒を含有する接着性シリコーンゴム組成物において、ケイ素原子数11~50の環状及び直鎖状の低分子無官能シロキサンの含有量が3重量%以下であることを特徴とする接着性シリコーンゴム組成物。

【効果】 本発明によれば、半導体チップと取付け部材との間の接着性が良好で、経時により接着性能が低下することがないため、半導体チップ/ボンディングワイヤー或いはボンディングワイヤー/リードフレーム間の接続信頼性が低下したり、封止材の半導体チップ、取付け部、リードフレームへの接着性が悪化し、装置の耐湿性が低下するといった問題を生じることがなく、半導体チップ取付け用の接着剤(ダイボンド剤)として良好に使用することができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (1)1分子中にケイ素原子に結合した アルケニル基を2個以上含有するオルガノポリシロキサ ン、(2)1分子中にケイ素原子に結合した水素原子を 2個以上含有するオルガノハイドロジェンポリシロキサ ン、(3)接着性付与剤、(4)付加反応触媒を含有す る接着性シリコーンゴム組成物において、ケイ素原子数 11~50の環状及び直鎖状の低分子無官能シロキサン の含有量が3重量%以下であることを特徴とする接着性 シリコーンゴム組成物。

【請求項2】 半導体チップの取付け部への接着用であ る請求項1記載の組成物。

【請求項3】 半導体チップを請求項2記載の組成物の 硬化物を介して取付け部に接着してなる半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、接着性シリコーン ゴム組成物に関し、特には半導体チップと取付け部材と の間の接着に使用される接着性シリコーンゴム組成物及 び半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体チップの接着には、半導体 チップとタブ等取付け部材との間の応力緩和効果を持つ シリコーンゴム系接着剤が使用されていた。これらは、 付加硬化タイプであり、接着成分としては、分子中にケ イ素原子に結合したアルコキシ基と、ケイ素原子に結合 したアルケニル基もしくはケイ素結合水素原子を、それ ぞれ1個以上含有する有機ケイ素化合物が用いられてき た (特開昭61-5530号公報、特許第288282 3号公報)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】これらの方法において は、半導体チップを取付け部に接着した後、半導体チッ プとリードフレーム等の回路配線とをボンディングワイ ヤーで接続し、更に封止材により全体を封止するが、使 用中に半導体チップ/ボンディングワイヤー或いはボン ディングワイヤー/リードフレーム間の接続信頼性が低 下したり、上記封止材の半導体チップ、取付け部、リー ドフレームへの接着性が悪化し、装置の耐湿性が低下す るといった問題があった。 * 40

$R^{1}aSiO(4-a)/2$

(式中、 R^1 は互いに同一又は異種の炭素数 $1\sim10$ 、 好ましくは1~8の非置換又は置換の一価炭化水素基で あり、aは1.5~2.8、好ましくは1.8~2. 5、より好ましくは1.95~2.05、更に好ましく は1.98~2.02の範囲の正数である。)

【 0 0 0 8 】上記 R¹で示されるケイ素原子に結合した 非置換又は置換の一価炭化水素基としては、例えばメチ ル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル *【0004】従って、本発明は、半導体チップと取付け 部材との間の接着性が良好で、経時により半導体装置の 信頼性を低下させることのない接着性シリコーンゴム組 成物及び半導体装置を提供することを目的とする。

2

[0005]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本 発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた 結果、シリコーンゴム組成物中に含まれるアルケニル 基、アルコキシ基、メタクリロキシアルキル基、メルカ プト基、ケイ素結合水素原子、水酸基、アミノ基、エポ 10 キシ基等の反応性官能基を分子中に含有しない、ケイ素 原子数11~50の環状或いは直鎖状低分子シロキサン が、組成物の加硫硬化後も架橋構造に化学結合により組 み込まれることなく、半導体チップの接着部分から徐々 にブリードしていき、半導体チップ/ボンディングワイ ヤー或いはボンディングワイヤー/リードフレーム間、 封止材の半導体チップ、取付け部、リードフレームとの 封止、接着部分に浸透していき、離型作用を発現して接 続信頼性の低下、接着性の悪化といった影響を及ぼして 20 いることを見出し、これらシロキサン含有量を3重量% 以下に削減することにより、上記悪影響を防止できるこ とを見出し、本発明を完成させた。

【0006】従って、本発明は、(1)1分子中にケイ 素原子に結合したアルケニル基を2個以上含有するオル ガノポリシロキサン、(2)1分子中にケイ素原子に結 合した水素原子を2個以上含有するオルガノハイドロジ ェンポリシロキサン、(3)接着性付与剤、(4)付加 反応触媒を含有する接着性シリコーンゴム組成物におい て、ケイ素原子数11~50の環状及び直鎖状の低分子 無官能シロキサンの含有量が3重量%以下であることを 特徴とする接着性シリコーンゴム組成物を提供する。ま た、本発明は、半導体チップがタブ等の取付け部材にこ の接着性シリコーンゴム組成物の硬化物で接着された半 導体装置を提供する。

【0007】以下、本発明につき更に詳しく説明する。 本発明の接着性シリコーンゴム組成物の第1成分である 1分子中にケイ素原子に結合するアルケニル基を2個以 上有するオルガノポリシロキサンは、本発明組成物の主 剤(ベースポリマー)となるものであり、下記平均組成 式(1)で示されるものが用いられる。

(1)

※ネオペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オク チル基、ノニル基、デシル基等のアルキル基、フェニル 基、トリル基、キシリル基、ナフチル基等のアリール 基、ベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロピル 基等のアラルキル基、ビニル基、アリル基、プロペニル 基、イソプロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基、シ クロヘキセニル基、オクテニル基等のアルケニル基や、 これらの基の水素原子の一部又は全部をフッ素、臭素、 基、イソブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、※50 塩素等のハロゲン原子、シアノ基等で置換したもの、例

えばクロロメチル基、クロロプロピル基、ブロモエチル基、3,3,3ートリフルオロプロピル基、2ーシアノエチル基等が挙げられる。

【0009】この場合、R¹のうち少なくとも2個はア ルケニル基(特に炭素数2~8のものが好ましく、更に 好ましくは2~6である)であることが必要である。な お、アルケニル基の含有量は、ケイ素原子に結合する全 有機基中(即ち、前記平均組成式(1)におけるR1と しての非置換又は置換の一価炭化水素基中)0.01~ 20モル%、特に0.1~10モル%とすることが好ま 10 しい。このアルケニル基は、分子鎖末端のケイ素原子に 結合していても、分子鎖途中のケイ素原子に結合してい ても、両者に結合していてもよいが、組成物の硬化速 度、硬化物の物性等の点から、本発明で用いるオルガノ ポリシロキサンは、少なくとも分子鎖末端のケイ素原子 に結合したアルケニル基を含んだものであることが好ま しい。なお、アルケニル基以外のR1としては、メチル 基、フェニル基、3,3,3-トリフルオロプロピル基 が好ましい。

【 0 0 1 0 】上記オルガノポリシロキサンの構造は、通 20 常は、主鎖がジオルガノシロキサン単位の繰り返しから*

 $R^{2}_{b}H_{c}SiO(4-b-c)/2$

で示され、1分子中に少なくとも2個、好ましくは2~200個、より好ましくは3~100個のケイ素原子結合水素原子(即ち、Si-H基)を有することが必要である。

【0013】上記式(2)中、R²は炭素数1~10の非置換又は置換の一価炭化水素基であり、このR²としては、上記式(1)中のR¹として例示したものと同様の基、好ましくはこれらのうちアルケニル基を除いたものと同様の基を挙げることができるが、特にメチル基、フェニル基、3,3,3ートリフルオロプロピル基が好ましい。また、bは0.7~2.1、cは0.001~1.0で、かつb+cは0.8~3.0を満足する正数であり、好ましくはbは1.0~2.0、cは0.01~1.0、b+cは1.5~2.5である。

【0014】1分子中に少なくとも2個、好ましくは3個以上含有されるSi-H基は、分子鎖末端、分子鎖途中のいずれに位置していてもよく、またこの両方に位置するものであってもよい。また、このオルガノハイドロジェンポリシロキサンの分子構造は、直鎖状、環状、分岐状、三次元網状構造のいずれであってもよいが、1分子中のケイ素原子の数(又は重合度)は通常2~300個、好ましくは4~150個程度の室温(25℃)で液状のものが望ましい。

【0015】式(2)のオルガノハイドロジェンポリシロキサンとして具体的には、例えば、1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン、メチルハイドロジェンシロコポリシロキサン、メチルハイドロジェンシロキサン・ジメチルシロキサン環状共重合体、両末端トリメチルシ※50

*なり、分子鎖両末端がトリメチルシロキシ基、ジメチルフェニルシロキシ基、ジメチルヒドロキシシロキシ基、ジメチルビニルシロキシ基等のトリオルガノシロキシ基で封鎖された基本的には直鎖状構造を有するジオルガノボリシロキサンであるが、部分的には分岐状構造、環状構造などであってもよい。平均重合度(重量平均重合度)は100~100,000、特に200~10,000であることが好ましく、また25℃における粘度は100~100,000、000 cSt(センチストークス)、特に1,000~1,000,000 cStであることが好ましい。

4

【0011】また、このアルケニル基含有オルガノポリシロキサンは、ケイ素原子数11~50の低分子無官能シロキサンの含有量が3重量%以下、特に2重量%以下であることが好ましい。

【0012】第2成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、第4成分の付加反応触媒の存在下に、第1成分のアルケニル基含有オルガノポリシロキサンと付加反応(ハイドロシリレーション反応)して組成物を硬化させる架橋剤として作用するものであり、下記平均組成式(2)

(2)

※ロキシ基封鎖メチルハイドロジェンポリシロキサン、両 末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メ チルハイドロジェンシロキサン共重合体、両末端ジメチ ルハイドロジェンシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサ ン、両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖ジメ チルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン共重 合体、両末端トリメチルシロキシ基封鎖メチルハイドロ ジェンシロキサン・ジフェニルシロキサン共重合体、両 末端トリメチルシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンシ ロキサン・ジフェニルシロキサン・ジメチルシロキサン 共重合体、両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封 鎖メチルハイドロジェンシロキサン・ジメチルシロキサ ン・ジフェニルシロキサン共重合体、(CH3)2HSi O1/2単位と(CH3)3SiO1/2単位とSiO4/2単位 とからなる共重合体、(CH3)2HSiO1/2単位とS i O4/2単位とからなる共重合体、(CH3)2HSiO 1/2単位とSiO4/2単位と(C6H5)3SiO1/2単位と からなる共重合体などが挙げられる。

【0016】このオルガノハイドロジェンポリシロキサンの配合量は、第1成分のオルガノポリシロキサン100部(重量部、以下同じ)に対して0.1~50部、特に0.3~20部とすることが好ましい。また、第2成分のオルガノハイドロジェンポリシロキサンは、第1成分中のケイ素原子に結合したアルケニル基1モルに対して、第2成分中のケイ素原子に結合した水素原子(Si-H基)の量が0.5~3モル、特に0.8~2.5モル程度となる量で配合することもできる。

【0017】第3成分の接着性付与剤は、分子中にケイ

素原子に結合したアルコキシ基及び/又はアルケニルオ キシ基と、Si-H基、アルケニル基、アクリル基、メ タクリル基、エポキシ基、メルカプト基、エステル基、 無水カルボキシ基、アミノ基及びアミド基から選ばれる 少なくとも1個の反応性官能基をそれぞれ1個以上含有 する、オルガノシラン或いはケイ素原子数2~50、好 ましくは4~20個程度のオルガノシロキサンオリゴマ ーなどの有機ケイ素化合物が好適に用いられる。この有 機ケイ素化合物は、シリコーンゴム組成物に半導体チッ プ、取付け部、リードフレーム等への接着性を付与する 10 ためのものであり、公知のものが使用でき、シリコーン ゴム組成物の付加加硫を阻害しないものであればよい。 【0018】このような有機ケイ素化合物としては、例 えば、 γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 トキシシラン等のエポキシ官能性基含有アルコキシシラ ン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシ ラン、ビニルトリ (メトキシエトキシ) シラン等のアル ケニル基含有アルコキシシラン、アーアミノプロピルト リメトキシシラン、アーアミノプロピルトリエトキシシ 20 ラン、 $N-\beta$ (アミノエチル) $-\gamma$ -アミノプロピルト リメトキシシラン、 $N-\beta$ (アミノエチル) $-\gamma$ -アミ ノプロピルメチルジメトキシシラン、 $N-フェニル-\gamma$ アミノプロピルトリメトキシシラン等のアミノ基含有 アルコキシシラン、アーメタクリロキシプロピルトリメ トキシシラン、ケーアクリロキシプロピルトリメトキシ シラン等のアクリル基又はメタクリル基含有アルコキシ シラン、メルカプトプロピルトリメトキシシラン等のメ ルカプト基含有アルコキシシランなどのアルコキシシラ ンが挙げられるほか、オルガノシロキサンオリゴマーと 30 して下記のような化合物が挙げられる。

[0019]

【化1】

$$\begin{array}{ccc} \mathsf{CH_3} & \mathsf{CH_3} \\ \mathsf{I} & \mathsf{I} \\ \mathsf{H}\text{-}\mathsf{Si}\text{-}\mathsf{O}\text{-}\mathsf{Si}\text{-}\mathsf{CH_2}\mathsf{CH_2}\mathsf{Si}(\mathsf{OCH_3})_3 \\ \mathsf{O} & \mathsf{O} \\ \mathsf{(CH_3O)_3}\mathsf{SiCH_2}\mathsf{CH_2}\text{-}\mathsf{Si}\text{-}\mathsf{O}\text{-}\mathsf{Si}\text{-}\mathsf{CH_2}\mathsf{CH_2}\mathsf{Si}(\mathsf{OCH_3})_3 \\ \mathsf{CH_3} & \mathsf{CH_3} \end{array}$$

【0020】 【化2】

ÇH₃ ÇH₃ H-Si-O-Si-CH₃ $H-\dot{S}i-O-\dot{S}i-(CH_2)_3OCONH(CH_2)_3Si(OCH_3)_3$ ĊH₃ ĊH₃

ÇH₃ ÇH₃ H-\$i-O-\$i-(CH₂)₃OCOCH₃ H-\$i-O-\$i-CH2CH2Si(OCH3)3 ĊH₃ ĊH₃

ÇH₃ ÇH₃ H-Si-O-Si-CH₃ H-\$i-O-\$i-(CH₂)₃OCO(CH₂)₃COO(CH₂)₃Si(OCH₃)₃ ĊH₃ ĊH₃

アルケニル基含有オルガノポリシロキサン100部に対 $0.1\sim10$ 部、特に $0.3\sim3$ 部とすることが好ま LW

【0022】第4成分の付加反応触媒としては、白金 黒、塩化第2白金、塩化白金酸、塩化白金酸と1価アル コールとの反応物、塩化白金酸とオレフィン類との錯 体、白金ビスアセトアセテート等の白金系触媒、パラジ ウム系触媒、ロジウム系触媒などの白金族金属触媒が挙 げられる。なお、この付加反応触媒の配合量は触媒量と することができ、通常、白金族金属として0.5~1, 000ppm、好ましくは1~500ppm程度とすれ ばよい。

【0023】本発明には、更に充填材を配合することが 好ましい。充填材は、シリコーンゴム組成物を補強し、 必要なゴム強度を与えるほか、接着作業に必要な粘度を 保つためのものであり、充填材としては補強性シリカ系 充填材及び/又はシリコーンレジンを使用する。補強性 シリカ系充填材としては、ヒュームドシリカ、焼成シリ カ、沈降シリカ等が挙げられ、その比表面積は50~4 00m²/g、特に100~300m²/gのものが好ま しい。シリコーンレジンとしては、R3SiO1/2単位、 SiO2单位、RSiO3/2单位、R2SiO2/2单位(R は水素原子、水酸基、又は同一もしくは異種の飽和もし くは不飽和の一価炭化水素基であり、そのうち90%以 上が一価炭化水素基)からなり、R3 S i O1/2単位は2 0~70モル%、SiO2単位は20~70モル%、R SiO_{3/2}単位は0~70モル%、R₂SiO_{2/2}単位は 0~50モル%の割合で存在するものが挙げられる。な お、Rのうち上記一価炭化水素基としては、上記R1で 説明したものと同様のものが挙げられるが、特にメチル 50 アルコキシ基、(メタ)アクリロキシアルキル基、メル

基、ビニル基、フェニル基であることが好ましい。

【0024】上記充填材の配合量は、第1成分のオルガ ノポリシロキサン100部に対し0~400部、特に5 100部とすることが好ましい。

8

【0025】上述した成分のほか、上記シリコーンゴム 組成物には、シラノール基含有シラン、アルコキシ基含 有シランなどの分散助剤、アセチレンアルコールその他 の付加加硫の制御剤、チタン、アルミニウム、ジルコニ ウム等の金属のキレート化合物或いはアルコキサイド、 10 珪藻土、石英粉末、溶融石英粉末、クレー、アルミナ、 水酸化アルミニウム、水酸化カルシウム、タルク等の無 機充填材、セリウム又はセリウム系化合物、酸化チタ ン、赤ベンガラ、黒ベンガラ、フェライト、酸化亜鉛、 炭酸亜鉛、炭酸マンガン、炭酸マグネシウム、酸化マグ ネシウムなどの耐熱、耐油向上剤、カーボンブラック、 群青などの着色のための顔料、離型剤、その他通常の付 加加硫型シリコーンゴム組成物に添加される添加剤を適 宜配合することができる。

【0026】本発明においては、シリコーンゴム組成物 【0021】上記接着性付与剤の配合量は、第1成分の 20 中に含まれるケイ素原子数11~50の環状及び直鎖状 の低分子無官能シロキサンの合計の含有量を組成物全体 に対して3重量%以下、特に2重量%以下とするもので ある。この場合、低分子無官能シロキサン含有量は少な ければ少ない程よいが、1、000ppm程度であれば 大きな影響はない。なお、このケイ素原子数11~50 の環状及び直鎖状の低分子無官能シロキサンの定量方法 としては、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ(G PC)、超臨界流体クロマトグラフィ等の分析手段を挙 げることができる。

> 【0027】ここで、無官能シロキサンとしては、アル コキシ基、Si-H基(ケイ素原子結合水素原子)、ア ルケニル基、アクリル基、メタクリル基、エポキシ基、 メルカプト基、エステル基、無水カルボキシ基、アミノ 基、アミド基等の、上記アルケニル基含有オルガノポリ シロキサンやオルガノハイドロジェンポリシロキサン、 更にはシリコーンゴム組成物が接着される基材と反応す る反応性官能基を有さない、環状及び直鎖状のジオルガ ノシロキサンであり、代表的にはジメチルポリシロキサ ン、メチルフェニルポリシロキサン、メチル(3,3, 3-トリフルオロプロピル) ポリシロキサンなどであ

【0028】このケイ素原子数11~50の低分子無官 能シロキサンは、例えば、上記アルケニル基含有オルガ ノポリシロキサンを、ケイ素原子数3~6の環状ジオル ガノポリシロキサンを原料とし、酸或いはアルカリを触 媒とした平衡重合反応により製造する際に、副生成物と して一定量生成するものであるが、本発明においては、 ケイ素原子数11~50の低分子無官能シロキサンの含 有量を3重量%以下とするものである。アルケニル基、

カプト基、ケイ素結合水素原子(SiH基)、水酸基、 アミノ基、エポキシ基等の反応性官能基を含有する低分 子シロキサンであれば、シリコーンゴム組成物の加硫の 際に反応性官能基も反応し、オルガノポリシロキサン、 オルガノハイドロジェンポリシロキサン、充填材、半導 体チップ、取付け部、リードフレーム等の被接着体等と の間に結合が生じるために硬化したシリコーンゴムマト リックス中での移動が妨げられ、接着部分から外にブリ ードすることもないので、接続信頼性の低下、接着性の 悪化といった影響は生じないのであるが、このような反 10 応性官能基を持たない低分子シロキサンの場合は、シリ コーンゴム組成物の加硫(又は硬化)に際しても、その 移動を妨げる結合が生じないので、加硫後も低分子シロ キサンはゴム内を自由に移動することができ、最終的に は、接着部分からブリードして悪影響を生じることにな る。

【0029】このような低分子無官能シロキサンの含有 量を3重量%以下にする方法としては、上記第1成分の アルケニル基含有オルガノポリシロキサンを0.1mm Hg以下の減圧下で200℃以上に加熱することで、低 20 分子無官能シロキサンを留去する方法、第1成分のアル ケニル基含有オルガノポリシロキサンをエタノールで洗 浄することで、低分子無官能シロキサンを除去する方 法、更には、第1成分のアルケニル基含有オルガノポリ シロキサンの製造方法として、ケイ素原子数3~6の環 状シロキサンを原料とし、酸或いはアルカリを触媒とし た平衡重合反応を用いる代わりに、ケイ素原子数3の環 状シロキサンを原料とし、リチウムシラノレート触媒の 存在下で開環重合反応を用いる方法等が挙げられる。

【0030】かくして得られる接着性シリコーンゴム組 30 成物は、半導体チップとタブ等取付け部材との間を接着 するための接着剤(ダイボンド剤)として使用すること ができる。一般に行われているように、接着面の片方或 いは両方に接着剤を塗布し、半導体チップや取付け部材 を密着させた後に、加熱処理(通常100~250℃) を行うことで接着することができ、また接着性の更なる 向上のために接着面を予め表面処理、コーティング等を 行うことは差し支えない。

[0031]

-[(CH₃)₂Si-O]₃-

(b) CH₂=CH-[\$i-O]₇-Li

$$O$$

 CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3)₃ (c)

1.0

*【発明の効果】本発明に係る、アルケニル基、アルコキ シ基、(メタ)アクリロキシアルキル基、メルカプト 基、ケイ素結合水素原子(SiH基)、水酸基、アミノ 基、エポキシ基等の反応性官能基を分子中に含有しな い、ケイ素原子数11~50の環状及び直鎖状の低分子 無官能シロキサン含有量が3重量%以下である付加加硫 型接着性シリコーンゴム組成物は、半導体チップと取付 け部材との間の接着性が良好で、経時により接着性能が 低下することがないため、半導体チップ/ボンディング ワイヤー或いはボンディングワイヤー/リードフレーム 間の接続信頼性が低下したり、封止材の半導体チップ、 取付け部、リードフレームへの接着性が悪化し、装置の 耐湿性が低下するといった問題を生じることがなく、半 導体チップ取付け用の接着剤 (ダイボンド剤) として良 好に使用することができる。

[0032]

【実施例】以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具 体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限される ものではない。なお、下記の例において部は重量部を示

【0033】 [実施例1] 下記式(a) で示される環状 シロキサンを、下記式(b)で示されるリチウムシラノ レート触媒を用いて重合した後、ビニルジメチルクロロ シランを用いて中和し、分子鎖両末端がジメチルビニル シロキシ基で封鎖された粘度が10,000センチスト ークスのオルガノポリシロキサン(1)を得た。このオ ルガノポリシロキサン(1)100部、ヒュームドシリ カ(日本エアロジル社製、商品名エロジル200)30 部、Si-H量0.0050モル/g、重合度100の オルガノハイドロジェンポリシロキサン5部、環状メチ ルビニルシロキサンO.8部、下記式(c)で示される 有機ケイ素化合物1部、塩化白金酸の2-エチルヘキサ ノール溶液(白金含有量2%)0.08部を均一に混合 し、液状シリコーンゴム組成物(1)を得た。ケイ素原 子数11~50の反応性官能基非含有の環状及び直鎖状 低分子ジメチルシロキサン含有量(GPC測定による、 以下同様)は1.2重量%であった。

(a)

【化3】

【0034】 [比較例1] オルガノポリシロキサン (1)の代わりに、ケイ素原子数3~6の環状ジメチル シロキサンとジビニルテトラメチルジシロキサンを、カ リウムシラノレートを用いて重合し、エピクロロヒドリ ンで中和することで得られた分子鎖両末端がジメチルビ ニルシロキシ基で封鎖された粘度が9,800センチス トークスのオルガノポリシロキサン(2)を用いた以外 は実施例1と同様の操作を行い、液状シリコーンゴム組 成物(2)を得た。ケイ素原子数11~50の反応性官 能基非含有の環状及び直鎖状低分子ジメチルシロキサン 10 で半導体ペレット上のアルミニウム製ボンディングパッ 含有量は5.5重量%であった。

【0035】 [実施例2] オルガノポリシロキサン (2)を、5倍重量のエタノールと混合、撹拌後、静置 してエタノールを分液除去することを3回行った後、1 OmmHg, 150℃の条件で3時間ストリップ操作を 行い、オルガノポリシロキサン(3)を得た。

【0036】オルガノポリシロキサン(1)の代わり に、オルガノポリシロキサン(3)を用いた以外は実施 例1と同様の操作を行い、液状シリコーンゴム組成物

非含有の環状及び直鎖状低分子ジメチルシロキサン含有 量は0.8重量%であった。

【〇〇37】[比較例2]液状シリコーンゴム組成物

(1)100部に、ケイ素原子数11~50の環状ジメ*

*チルシロキサン5.0部を添加混合し、液状シリコーン ゴム組成物(4)を得た。ケイ素原子数11~50の反 応性官能基非含有の環状及び直鎖状低分子ジメチルシロ キサン含有量は5.9重量%となった。

12

【0038】次に、上記組成物につき、下記方法で接続 信頼性試験を行った。結果を表1に示す。

[接続信頼性試験] 10mm×10mmの半導体ペレッ トを、上記液状シリコーンゴム組成物を用いて金属製取 付けタブに200℃,60秒の加熱により接着し、次い ドと銅製リードフレームを、金製ワイヤーを用いて超音 波熱圧着により接続した。これをエポキシ樹脂で封止す ることにより半導体装置を作製した。

【0039】このようにして作製した半導体装置、この 半導体装置を150℃のオーブン中一定時間放置した後 のもの、この半導体装置を121℃,湿度85%RHの プレッシャークッカの中に一定時間放置した後のもの、 また、この半導体装置を−65~150℃の熱負荷を周 期的に繰り返す温度サイクルに一定回数かけたものにつ (3)を得た。ケイ素原子数11~50の反応性官能基 20 いて、通電し、導通不良やリークといった不良の生じた ものを計数した。試験体は、それぞれ10個試験を行っ た。

[0040]

【表1】

2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	•	F-2-4			
不良発生個数	実施例 1	実施例 2	比較例 1	比較例 2	
初期	0/10	0/10	0/10	0/10	
150℃/500 時間後	0/10	0/10	0/10	0/10	
121℃85%RH/168 時間後	0/10	0/10	4/10	3/10	
121℃85%RH/500 時間後	0/10	0/10	6/10	5/10	
-65~150℃温度サイクル 500 回後	0/10	0/10	2/10	2/10	

【0041】上記の結果より、半導体ペレットの取付け 30※止材の半導体チップ、取付け部、リードフレームへの接 タブへの接着に、ケイ素原子数11~50の反応性官能 基非含有の環状或いは直鎖状低分子シロキサン含有量が 3重量%を超えて含有する接着性シリコーンゴム組成物 を用いた場合、半導体チップ/ボンディングワイヤー或 いはボンディングワイヤー/リードフレーム間、上記封※

着性が悪化し、不良が発生する。

【0042】これらに対し、本発明の接着性シリコーン ゴム組成物を用いた場合には、経時による接続信頼性の 低下がなく、優れた信頼性の半導体装置が提供されるこ とが確認された。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4J035 BA02 CA021 CA141 HA01

HB03 LA04 LB02

4J040 EK032 EK041 EK042 EK101

EK102 GA01 GA03 GA13

HA066 HA096 HD30 HD35

HD36 HD37 HD43 JA03 JB02

KA14 KA26 LA06 MA02 MA10

NA20 PA30

5F047 AA11 BA23 BA26 BA33 BB11

BB16